
	<p>SI7772DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7772DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7772DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 20645 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7772DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	20645 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 35.6A (Tc) 3.9W (Ta), 29.8W (Tc)
Serie	SkyFET®, TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	3.9W (Ta), 29.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1084pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7772DP-T1-GE3DKR

SI7772DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7772DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7772DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7772DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7774DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7772DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SI7758DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7758DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7758DP VB SI7758DP VB</p>	 <p>SI7788DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SI7784DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7774DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⚙ SI7716ADN-T1-GE3 | ➔ SI7716ADN-T1-GE3 | ➔ SI7716DN-T1-GE3 | D SI7720DN-T1-E3 | ➔ SI7720DN-T1-GE3 |
| ⊣ SI7720DN-T1-GE3 | ⚙ SI7726DN | D SI7726DN-T1-E3 | ➔ SI7726DN-T1-GE3 | ➔ SI7726DN-T1-GE3 |
| ⚙ SI7732DP-T1-GE3 | ⊣ SI7738DP | ⚙ SI7738DP-T1-3 | ➔ SI7738DP-T1-E3 | ➔ SI7738DP-T1-E3 |
| D SI7738DP-T1-GE3 | ⚙ SI7738DP-T1-GE3 | ⊣ SI7742DP-T1-E3 | ⚙ SI7742DP-T1-GE3 | ➔ SI7742DP-T1-GE3 |
| ➔ SI7748DP-T1-GE3 | ➔ SI7748DP-T1-GE3 | ⚙ SI7758DP | ⊣ SI7758DP-T1-GE3 | ➔ SI7758DP-T1-GE3 |
| ➔ SI7772DP-T1-GE3 | ➔ SI7774DP-T1-GE3 | D SI7774DP-T1-GE3 | ⚙ SI7784DP-T1-GE3 | ⊣ SI7784DP-T1-GE3 |
| ⚙ SI7788DP-T1-GE3 | D SI7788DP-T1-GE3 | ➔ SI7790DP-T1-E3 | ➔ SI7790DP-T1-GE3 | ➔ SI7790DP-T1-GE3 |
| ⊣ SI7792DP-T1-GE3 | ⚙ SI7792DP-T1-GE3 | ➔ SI7794DP-T1-GE3 | ➔ SI7794DP-T1-GE3 | ➔ SI7798DP-T1-GE3 |
| ⚙ SI7804DN | ⊣ SI7804DN-T1-E3 | ⚙ SI7804DN-T1-E3 | D SI7806ADN | ➔ SI7806ADN-T1-E3 |
| ➔ SI7806ADN-T1-E3 | ⚙ SI7806ADN-T1-E3-PBF | ⊣ SI7806ADN-T1-GE3 | ⚙ SI7806ADN-T1-GE3 | ➔ SI7806AEDN-T1-E3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited